

DIODE-PENTODE with variable mutual conductance for use as R.F., I.F. or A.F. amplifier
 DIODE-PENTHODE à pente variable pour l'utilisation comme amplificatrice H.F., M.F. ou B.F.
 DIODE-PENTODE mit veränderlicher Steilheit zur Verwendung als HF-, ZF- oder NF-Verstärker

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply

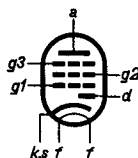
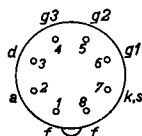
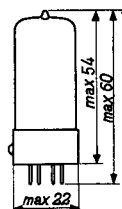
Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; $V_f = 6,3 \text{ V}$
 alimentation en parallèle

Heizung: indirekt durch Wechsel- oder Gleichstrom; Parallelspeisung $I_f = 0,2 \text{ A}$

Dimensions in mm

Dimensions en mm

Abmessungen in mm



Base, culot, Sockel: Rimlock

Capacitances
 Capacités
 Kapazitäten

Pentode section
 Partie penthode
 Pentodenteil

Diode section
 Partie diode
 Diodenteil

$C_a = 5,2 \text{ pF}$

$C_d = 3,3 \text{ pF}$

$C_{g1} = 4,1 \text{ pF}$

$C_{df} < 0,02 \text{ pF}$

$C_{ag1} < 0,002 \text{ pF}$

$C_{glf} < 0,05 \text{ pF}$

Between diode and pentode sections
 Entre les parties diode et penthode
 Zwischen Dioden- und Pentodenteil

$C_{dg1} < 0,0015 \text{ pF}$

$C_{da} < 0,15 \text{ pF}$

Operating characteristics of the pentode section as R.F. or I.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode comme amplificateur H.F. ou M.F.

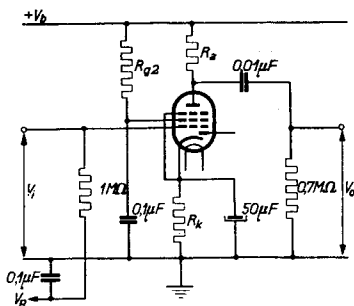
Betriebsdaten des Pentodenteiles als HF- oder ZF-Verstärker

$V_a=V_b =$	250	V
$V_{g3} =$	0	V
$R_{g2} =$	110	k Ω
$R_k =$	310	Ω
$V_{g1} =$	$\overbrace{-2 \quad \quad \quad -43}$	V
$V_{g2} =$	85	V
$I_a =$	5	mA
$I_{g2} =$	1,5	mA
$S =$	2000	$\mu A/V$
$R_i =$	1,4	>10 M Ω
$\mu_{g2g1} =$	16	
$R_{eq} =$	7,5	k Ω

Operating characteristics of the pentode section as resistance coupled A.F. amplifier

Caractéristiques d'utilisation de la partie penthode comme amplificateur B.F. avec couplage à résistances

Betriebsdaten des Pentodenteiles als NF-Verstärker mit Widerstandskopplung



This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage $V_i \geq 10$ mV for an output of 50 mW of the output valve ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée $V_i \geq 10$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 10$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

A. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,22 \text{ M}\Omega$; $R_{g2} = 0,82 \text{ M}\Omega$; $R_k = 1,5 \text{ k}\Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	0,80	0,26	120	0,9	1,0	1,2
5	0,65	0,20	40	1,3	1,5	2,5
10	0,52	0,17	23	1,3	1,6	2,7
15	0,41	0,14	16	1,5	2,0	3,2
20	0,31	0,11	11	1,8	2,7	5,5

B. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$; $R_{g2} = 0,39 \text{ M}\Omega$; $R_k = 680 \Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	1,52	0,53	100	0,8	0,9	1,0
5	1,20	0,40	35	1,0	1,4	2,4
10	0,94	0,30	20	1,2	2,0	3,2
15	0,70	0,23	13	1,4	2,3	3,7
20	0,52	0,17	9	1,8	3,0	6,0

Operating characteristics as resistance coupled L.F. amplifier in triode connection (g_2 connected to anode)
Données caractéristiques comme amplificatrice B.F. avec couplage à résistances montée en triode (g_2 reliée à l'anode)

Betriebsdaten als N.F.Verstärker mit Widerstandskopplung in Triodenschaltung (g_2 verbunden mit Anode)

This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage $V_i \geq 10$ mV for an output of 50 mW of the output valve ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée $V_i \geq 10$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 10$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben ($R_{g1} = 1 \text{ M}\Omega$)

A. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,22 \text{ M}\Omega$; $R_{g2} = 0,82 \text{ M}\Omega$; $R_k = 1,5 \text{ k}\Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	0,80	0,26	120	0,9	1,0	1,2
5	0,65	0,20	40	1,3	1,5	2,5
10	0,52	0,17	23	1,3	1,6	2,7
15	0,41	0,14	16	1,5	2,0	3,2
20	0,31	0,11	11	1,8	2,7	5,5

B. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$; $R_{g2} = 0,39 \text{ M}\Omega$; $R_k = 680 \Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	I_{g2} (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	1,52	0,53	100	0,8	0,9	1,0
5	1,20	0,40	35	1,0	1,4	2,4
10	0,94	0,30	20	1,2	2,0	3,2
15	0,70	0,23	13	1,4	2,3	3,7
20	0,52	0,17	9	1,8	3,0	6,0

A. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,1 \text{ M}\Omega$; $R_k = 680 \Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	2,00	15	0,9	1,1	1,2
5	1,50	8,5	1,1	1,6	2,4
10	1,17	6	1,1	1,6	2,4
15	0,90	5	1,1	1,6	2,4
20	0,68	4	1,2	1,7	2,6

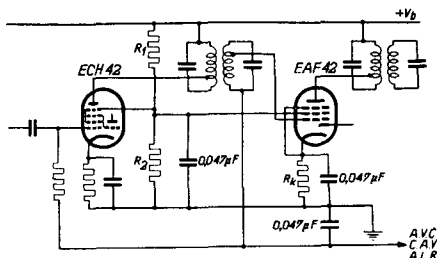
B. $V_b = 250 \text{ V}$; $R_a = 0,05 \text{ M}\Omega$; $R_k = 390 \Omega$

$-V_R$ (V)	I_a (mA)	$\frac{V_o}{V_i}$	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=3V_{eff}$)	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} \text{ (%)}$ ($V_o=8V_{eff}$)
0	3,80	14	0,7	0,9	1,1
5	2,70	9	1,1	1,6	2,6
10	2,00	6,5	1,1	1,6	2,6
15	1,44	5	1,1	1,6	2,6
20	1,05	4	1,4	2,2	3,4

Operating characteristics as I.F. amplifier (screen grids of EAF 42 and ECH 42 fed from a common potentiometer)

Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. (grilles-écran des tubes EAF 42 et ECH 42 connectées à un potentiomètre commun)

Betriebsdaten als Z.F. Verstärker (Schirmgitter der Röhren EAF 42 und ECH 42 verbunden mit einem gemeinsamen Spannungsteiler)



Limiting values of the pentode section
 Caractéristiques limites de la partie penthode
 Grenzdaten des Pentodenteiles

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V
W_a	= max.	2 W
V_{g20}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_a < 2,5 \text{ mA})$	= max.	300 V
$V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA})$	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,3 W
I_k	= max.	10 mA
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
R_{g1}	= max.	3 M Ω
R_{g3}	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	100 V

Limiting values of the diode section
 Caractéristiques limites de la partie diode
 Grenzdaten des Diodenteiles

V_{dinvp}	= max.	350 V
I_d	= max.	0,8 mA
I_{d_p}	= max.	5 mA
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	100 V

$V_a = V_b =$	250		V
$R_1 =$	22		k Ω
$R_2 =$	27		k Ω
$R_k =$	310		Ω
$V_{g1} =$	-2	-20,5	V
$V_{g2} =$	85	137	V
$I_a =$	5	-	mA
$I_{g2} =$	1,5	-	mA
$S =$	2000	20	$\mu A/V$
$R_1 =$	1,4	>10	M Ω
$\mu_{g2g1} =$	16	-	
$R_{eq} =$	7,5	-	k Ω

Operating characteristics as I.F. amplifier (screen grids of EAF42 and ECH41 fed from a common potentiometer)

Caractéristiques d'utilisation comme amplificateur M.F. (grilles-écran des tubes EAF 42 et ECH 41 connectées à un potentiomètre commun)

Betriebsdaten als ZF-Verstärker (Schirmgitter der Röhren EAF 42 und ECH 41 verbunden mit einem gemeinsamen Spannungsteiler)

For circuit diagram see page 4.

Pour le schéma voir page 4.

Für das Schaltbild siehe Seite 4.

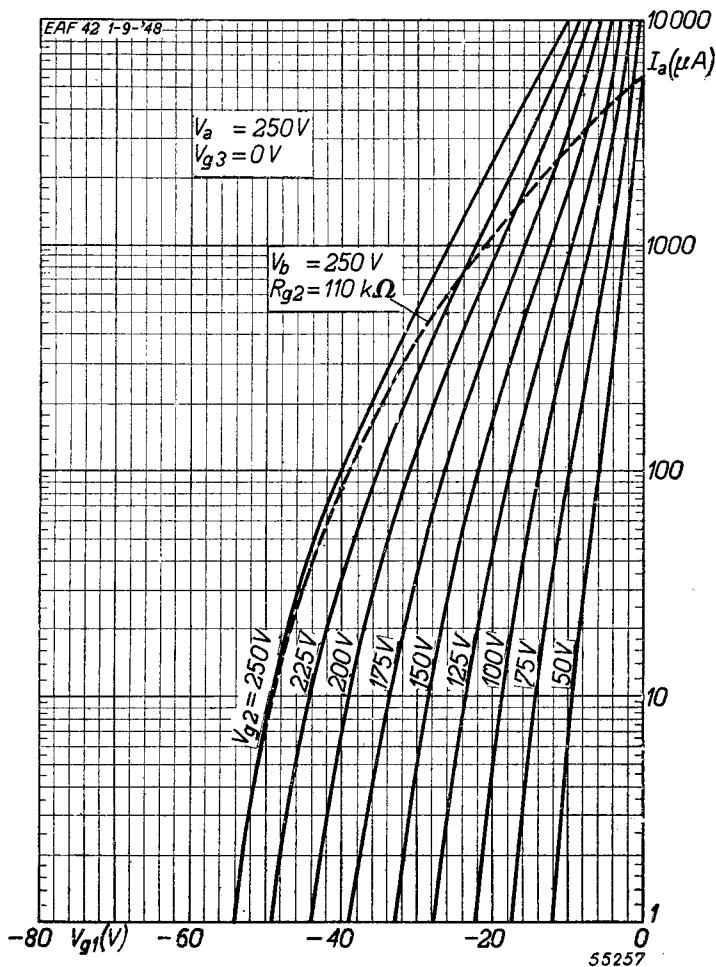
$V_a = V_b =$	250		V
$R_1 =$	18		k Ω
$R_2 =$	27		k Ω
$R_k =$	220		Ω
$V_{g1} =$	-2	-23,5	V
$V_{g2} =$	105	147	V
$I_a =$	6,9	-	mA
$I_{g2} =$	2,1	-	mA
$S =$	2150	21,5	$\mu A/V$
$R_1 =$	1,4	>10	M Ω
$\mu_{g2g1} =$	16	-	
$R_{eq} =$	9	-	k Ω

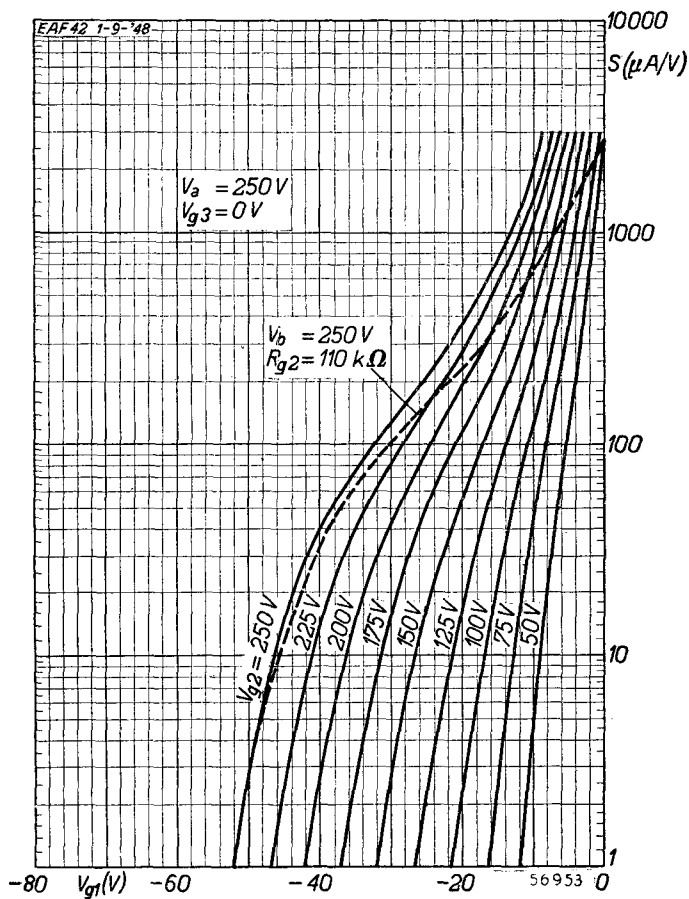
Limiting values of the pentode section
Caractéristiques limites de la partie penthode
Grenzdaten des Pentodenteiles

V_{a0}	= max.	550 V
V_a	= max.	300 V
W_a	= max.	2 W
V_{g2_0}	= max.	550 V
$V_{g2} (I_a < 2,5 \text{ mA})$	= max.	300 V
$V_{g2} (I_a = 5 \text{ mA})$	= max.	125 V
W_{g2}	= max.	0,3 W
I_k	= max.	10 mA
$V_{g1} (I_{g1} = +0,3 \mu\text{A})$	= max.	-1,3 V
R_{g1}	= max.	3 M Ω
R_{g3}	= max.	3 M Ω
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	100 V

Limiting values of the diode section
Caractéristiques limites de la partie diode
Grenzdaten des Diodenteiles

V_{dinv_p}	= max.	350 V
I_d	= max.	0,8 mA
I_{d_p}	= max.	5 mA
R_{kf}	= max.	20 k Ω
V_{kf}	= max.	100 V

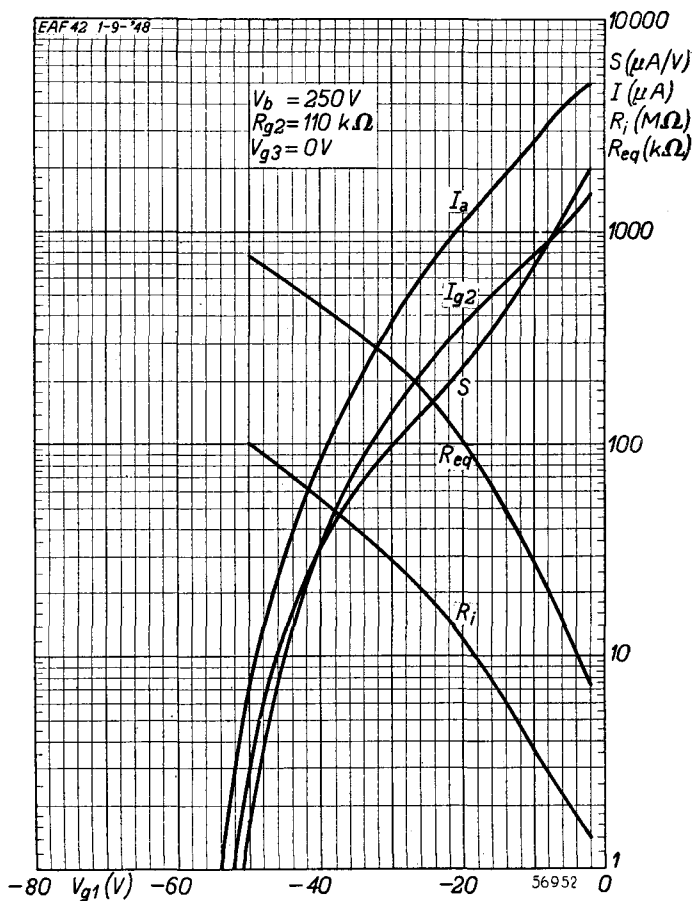


EA42**PHILIPS**

B

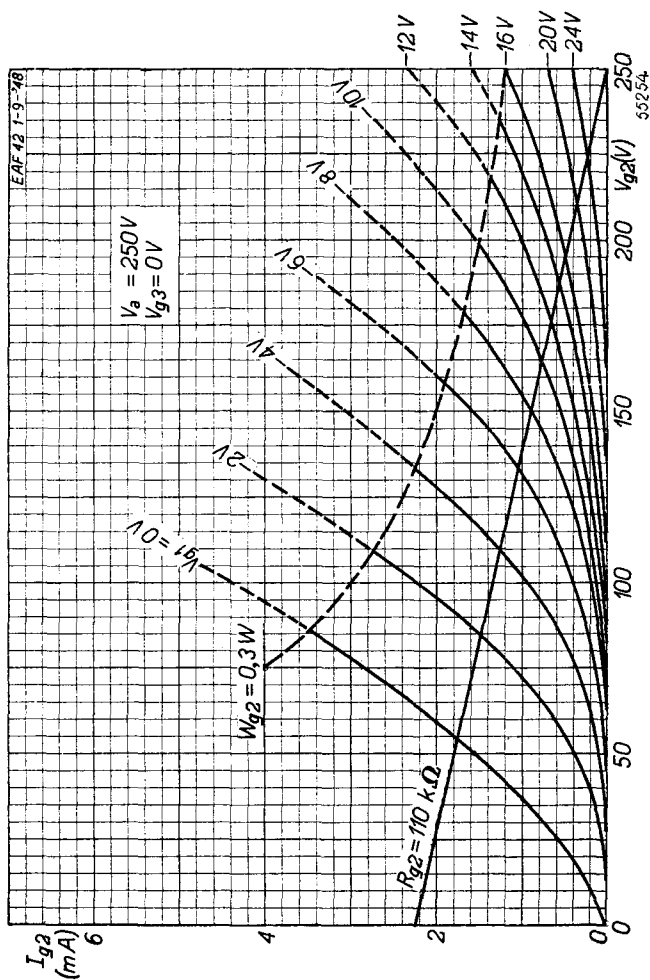
PHILIPS

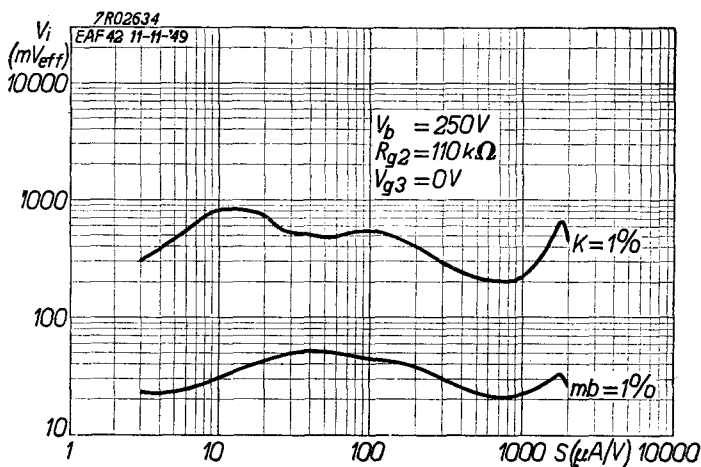
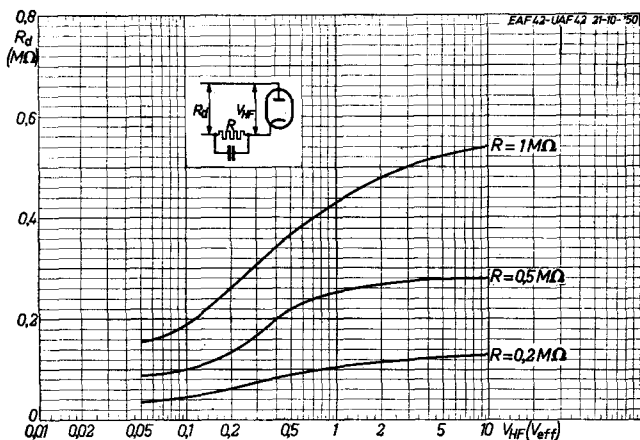
EAF 42



25.1.1949

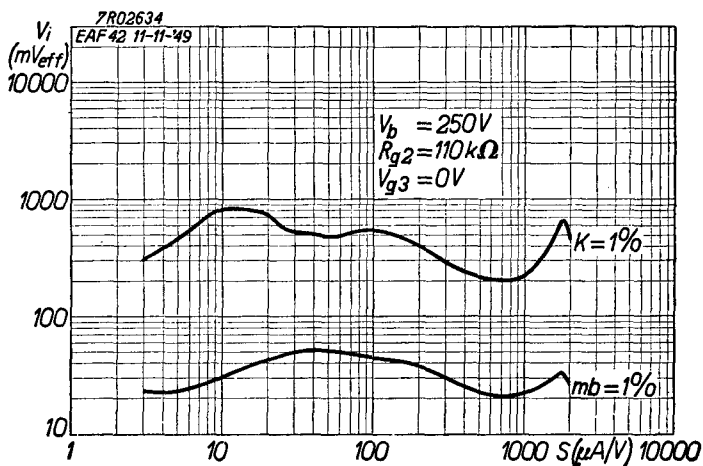
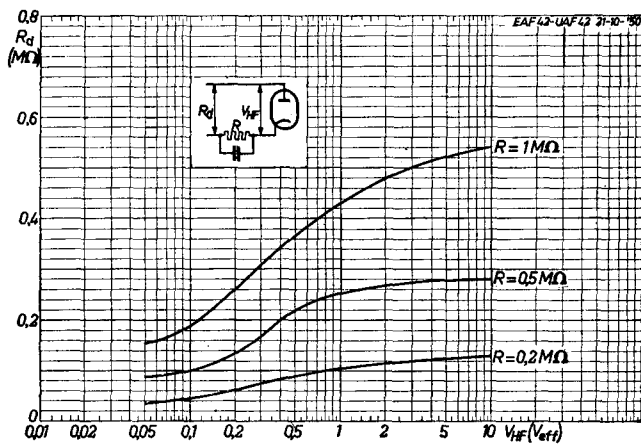
C





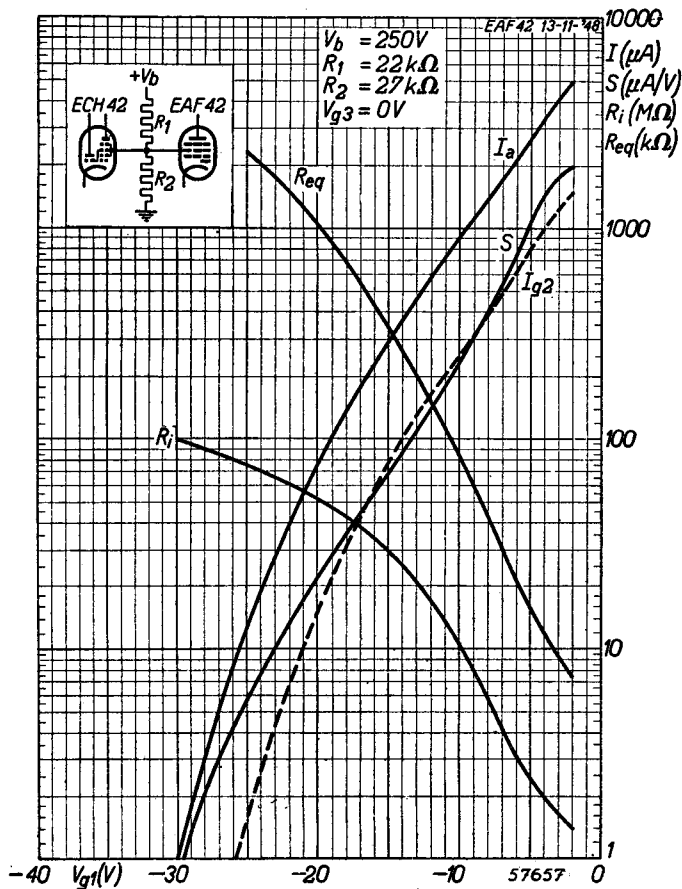
PHILIPS

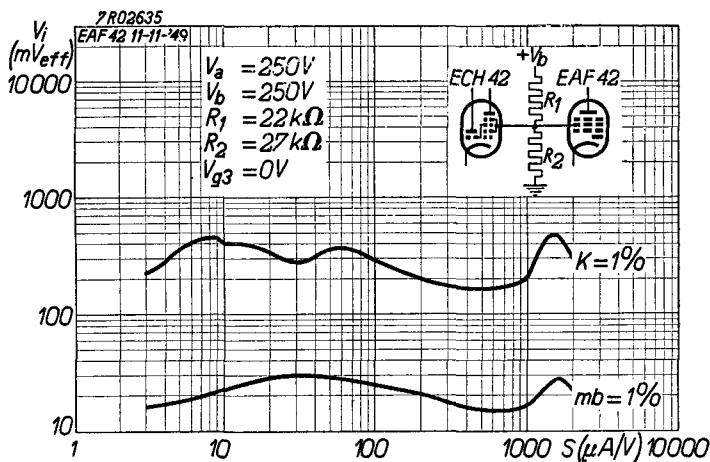
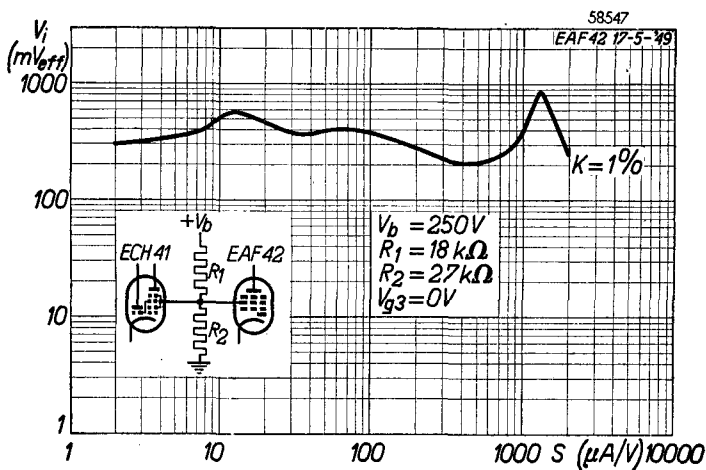
EAf 42



10.10.1957

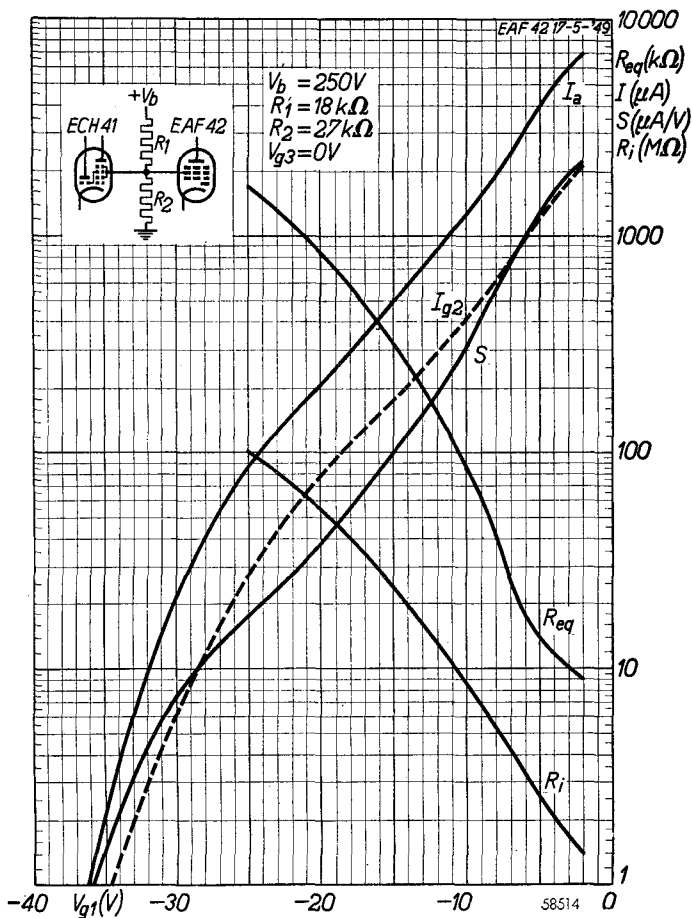
E

EAF 42**PHILIPS**



EAF 42

PHILIPS





	EAF42	
page	sheet	date
1	01531010	1953.1010
2	02531010	1953.1010
3	03481108	1948.11.08
4	03601010	1960.10.10
5	04481108	1948.11.08
6	04601010	1960.10.10
7	05531010	1953.1010
8	06531010	1953.1010
9	A_490125	1949.01.25
10	B_490125	1949.01.25
11	C_490125	1949.01.25
12	D_490125	1949.01.25
13	E_501212	1950.12.12
14	E_571010	1957.10.10
15	F_501212	1950.12.12
16	G_491111	1949.11.11
17	H_491111	1949.11.11
18	FP	2010.12.29